



(12)

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
**26.02.2020 Bulletin 2020/09**

(51) Int Cl.:  
**H01L 27/32<sup>(2006.01)</sup> H01L 51/52<sup>(2006.01)</sup>**

(21) Numéro de dépôt: **19192318.4**

(22) Date de dépôt: **19.08.2019**

(84) Etats contractants désignés:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR**  
Etats d'extension désignés:  
**BA ME**  
Etats de validation désignés:  
**KH MA MD TN**

(72) Inventeurs:  
• **MOLLARD, Laurent**  
**38054 GRENOBLE Cedex 09 (FR)**  
• **MAINDRON, Tony**  
**38054 GRENOBLE Cedex 09 (FR)**  
• **TOURNAIRE, Myriam**  
**38054 GRENOBLE Cedex 09 (FR)**  
  
(74) Mandataire: **GIE Innovation Competence Group**  
**310, avenue Berthelot**  
**69372 Lyon Cedex 08 (FR)**

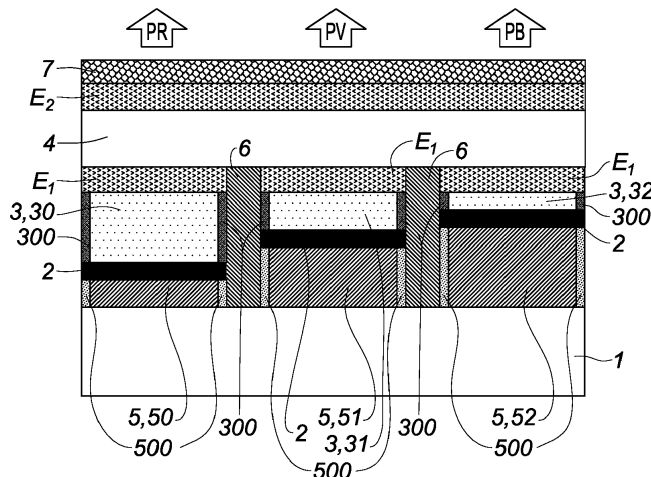
(30) Priorité: **21.08.2018 FR 1857558**

(71) Demandeur: **Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives**  
**75015 Paris (FR)**

(54) **PIXEL D'UN MICRO-ECRAN A DIODES ELECTROLUMINESCENTES ORGANIQUES**

(57) Ce pixel comporte successivement :  
- un substrat (1) ;  
- un réflecteur (2), réfléchissant dans le domaine visible ;  
- une couche d'espacement (3) ;  
- une première électrode ( $E_1$ ), transparente ;  
- un empilement (4) de couches électroluminescentes organiques, configuré pour émettre une lumière blanche ;  
- une seconde électrode ( $E_2$ ), semi-transparente, et formée sur l'empilement (4) ; la seconde électrode ( $E_2$ ) et

le réflecteur (2) formant un résonateur optique ;  
la couche d'espacement (3) possédant des première, deuxième, et troisième portions (30, 31, 32) présentant des épaisseurs adaptées de sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue ;  
remarquable en ce que les première et deuxième portions (30, 31) de la couche d'espacement (3) comportent chacune des bords latéraux (300) recouverts d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible.



**Fig. 1**

## Description

### Domaine technique

[0001] L'invention se rapporte au domaine technique des micro-écrans à diodes électroluminescentes organiques.

[0002] L'invention trouve notamment son application dans la fabrication de lunettes et casques à réalité virtuelle ou augmentée, de viseurs d'appareil photo, d'afficheurs tête haute, de pico-projecteurs etc.

### Etat de la technique antérieure

[0003] Un pixel d'un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques connu de l'état de la technique, notamment du document US 8,956,898 B2, comporte successivement :

- un substrat ;
- un réflecteur, réfléchissant dans le domaine visible, et formé sur le substrat ;
- une couche d'espacement, formée sur le réflecteur ;
- une première électrode, transparente dans le domaine visible, et formée sur la couche d'espacement ;
- un empilement de couches électroluminescentes organiques, configuré pour émettre une lumière blanche, et formé sur la première électrode,
- une seconde électrode, semi-transparente dans le domaine visible, et formée sur l'empilement ; la seconde électrode et le réflecteur formant un résonateur optique ;

la couche d'espacement possédant des première, deuxième, et troisième portions présentant des épaisseurs adaptées de sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue issues de la lumière blanche émise par l'empilement, de manière à définir respectivement des sous-pixels rouge, vert et bleu.

[0004] Un tel pixel de l'état de la technique permet, grâce au réflecteur et à la couche d'espacement agencés sous la première électrode transparente, de déposer aisément l'empilement de couches électroluminescentes organiques sur la première électrode qui forme une surface plane, ce qui n'est pas possible pour d'autres architectures telles que celle décrite dans le document EP 1 672 962 A1, où l'empilement est formé sur la couche d'espacement qui est non-plane (trois portions d'épaisseurs différentes).

[0005] En outre, un tel pixel de l'état de la technique permet d'envisager de s'affranchir de filtres colorés grâce au résonateur optique de type Fabry-Pérot formant un filtre interférentiel. La gamme de longueurs d'onde filtrées est déterminée par les épaisseurs des première, deuxième et troisième portions de la couche d'espacement permettant d'ajuster l'épaisseur de la cavité optique (délimitée par le réflecteur et la seconde électrode) de

sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue issue de la lumière blanche émise par l'empilement de couches électroluminescentes organiques.

5 [0006] Toutefois, un tel pixel de l'état de la technique n'est pas entièrement satisfaisant dans la mesure où la commande électronique des sous-pixels rouge, vert et bleu est susceptible de conduire à des phénomènes de diaphonie (« *crosstalk* » en langue anglaise) entre des sous-pixels adjacents.

### Exposé de l'invention

[0007] L'invention vise à remédier en tout ou partie aux inconvénients précités. A cet effet, l'invention a pour objet un pixel d'un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant successivement :

- un substrat ;
- 20 - un réflecteur, réfléchissant dans le domaine visible, et formé sur le substrat ;
- une couche d'espacement, formée sur le réflecteur ;
- une première électrode, transparente dans le domaine visible, et formée sur la couche d'espacement ;
- 25 - un empilement de couches électroluminescentes organiques, configuré pour émettre une lumière blanche, et formé sur la première électrode,
- une seconde électrode, semi-transparente dans le domaine visible, et formée sur l'empilement ; la seconde électrode et le réflecteur formant un résonateur optique ;

la couche d'espacement possédant des première, deuxième, et troisième portions présentant des épaisseurs adaptées de sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue issues de la lumière blanche émise par l'empilement, de manière à définir respectivement des sous-pixels rouge, vert et bleu ;

40 remarquable en ce que les première et deuxième portions de la couche d'espacement comportent chacune des bords latéraux recouverts d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible.

[0008] Ainsi, un tel pixel selon l'invention permet de réduire significativement les effets de diaphonie entre les sous-pixels rouge et vert grâce aux bords latéraux réfléchissants des première et deuxième portions de la couche d'espacement qui améliorent le confinement des rayons lumineux réfléchis dans la cavité optique.

### Définitions

#### [0009]

- 55 - Par « micro-écran », on entend un écran dont chaque pixel présente une surface inférieure ou égale à 30  $\mu\text{m}$  par 30  $\mu\text{m}$ .
- Par « substrat », on entend un support physique

autoporté, réalisé dans un matériau de base permettant l'intégration d'un dispositif électronique ou d'un composant électronique. Un substrat est classiquement une tranche (« *wafers* » en langue anglaise) découpée dans un lingot monocristallin de matériau semi-conducteur.

- Par « domaine visible », on entend un spectre électromagnétique compris entre 380 nm et 780 nm.
- Par « réfléchissant », on entend que l'élément correspondant (i.e. le réflecteur ou le matériau recouvrant les bords latéraux) possède un coefficient de réflexion en intensité supérieur ou égal à 70%, de préférence supérieur ou égal à 80%, plus préférentiellement supérieur ou égal à 85%, encore plus préférentiellement supérieur ou égal à 90%, moyenné sur le domaine visible.
- Par « semi-transparente », on entend que la seconde électrode possède un coefficient de transmission en intensité strictement inférieur à 80%, de préférence strictement inférieur à 70%, plus préférentiellement strictement inférieur à 60%, moyenné sur le domaine visible.
- Par « transparente », on entend que la première électrode possède un coefficient de transmission en intensité supérieur ou égal à 70%, de préférence supérieur ou égal à 80%, plus préférentiellement supérieur ou égal à 85%, encore plus préférentiellement supérieur ou égal à 90%, moyenné sur le domaine visible.
- Par « épaisseur », on entend la dimension suivant la normale à la surface du pixel ou du sous-pixel.
- Par « bords latéraux », on entend les bords longitudinaux s'étendant suivant une direction perpendiculaire à la normale au substrat (i.e. la normale à la surface du pixel ou du sous-pixel).

**[0010]** Le pixel selon l'invention peut comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes.

**[0011]** Selon une caractéristique de l'invention, la troisième portion de la couche d'espacement comporte des bords latéraux recouverts d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible.

**[0012]** Ainsi, un avantage procuré est de réduire significativement les effets de diaphonie entre les sous-pixels rouge, vert et bleu grâce aux bords latéraux réfléchissants des première, deuxième et troisième portions de la couche d'espacement qui améliorent le confinement des rayons lumineux réfléchis dans la cavité optique.

**[0013]** Selon une caractéristique de l'invention, l'épaisseur de la troisième portion de la couche d'espacement est nulle, et le résonateur optique présente une épaisseur adaptée pour autoriser la transmission d'une lumière bleue issue de la lumière blanche émise par l'empilement.

**[0014]** Ainsi, un avantage procuré est de simplifier la fabrication du sous-pixel bleu en s'affranchissant du contrôle de l'épaisseur de la troisième portion de la couche d'espacement.

**[0015]** Selon une caractéristique de l'invention, le substrat comporte une couche diélectrique structurée, de préférence réalisée en SiO<sub>2</sub> ou en SiN, sur laquelle est formé le réflecteur ; la couche diélectrique structurée

- 5 comprenant des premier, deuxième et troisième motifs associés respectivement aux sous-pixels rouge, vert et bleu ;  
 et les premier, deuxième et troisième motifs comportent  
 10 chacun des bords latéraux recouverts d'un matériau électriquement conducteur, de préférence sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W ; les bords latéraux des premier, deuxième et troisième motifs étant électriquement isolés entre eux.

**[0016]** Par « diélectrique », on entend que la couche présente une conductivité électrique à 300 K inférieure ou égale à 10<sup>-6</sup> S/cm.

**[0017]** Par « électriquement conducteur », on entend que le matériau présente une conductivité électrique à 300 K supérieure ou égale à 10<sup>2</sup> S/cm.

**[0018]** Ainsi, un avantage procuré est la formation de trous d'interconnexion (« *vias* » en langue anglaise), dont les parois sont définies par deux bords latéraux appartenant à deux motifs adjacents, en regard l'un de l'autre. Les parois des trous d'interconnexion sont donc électriquement conductrices et l'intérieur des parois peut être rempli d'un matériau diélectrique. De tels trous d'interconnexion se distinguent de l'état de la technique où les parois sont diélectriques et l'intérieur des parois est électriquement conducteur.

**[0019]** Selon une caractéristique de l'invention, le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux des première et deuxième portions de la couche d'espacement est électriquement conducteur ;

et les bords latéraux des premier et deuxième motifs de la couche diélectrique structurée s'étendent respectivement dans le prolongement des bords latéraux des première et deuxième portions de la couche d'espacement.

**[0020]** Ainsi, un avantage procuré est de connecter électriquement les trous d'interconnexion (formés par deux bords latéraux de deux motifs adjacents) à la première électrode par l'intermédiaire des bords latéraux des première et deuxième portions de la couche d'espacement. Une telle architecture permet d'accéder facilement, avec un encombrement réduit, à un circuit de commande des sous-pixels rouge et vert, intégré au substrat.

**[0021]** Selon une caractéristique de l'invention, le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux des première, deuxième et troisième portions de la couche d'espacement est électriquement conducteur ;

et les bords latéraux des premier, deuxième et troisième motifs de la couche diélectrique structurée s'étendent respectivement dans le prolongement des bords latéraux des première, deuxième et troisième portions de la couche d'espacement.

**[0022]** Ainsi, un avantage procuré est de connecter électriquement les trous d'interconnexion (formés par deux bords latéraux de deux motifs adjacents) à la première électrode par l'intermédiaire des bords latéraux

des première, deuxième et troisième portions de la couche d'espacement. Une telle architecture permet d'accéder facilement, et de manière compacte, à un circuit de commande des sous-pixels rouge, vert et bleu, intégré au substrat.

**[0023]** Selon une caractéristique de l'invention, le substrat comporte un circuit CMOS ;

et les bords latéraux des premier, deuxième et troisième motifs de la couche diélectrique structurée sont reliés électriquement au circuit CMOS.

**[0024]** Ainsi, un avantage procuré est d'accéder facilement, avec un encombrement réduit, au circuit de commande CMOS des sous-pixels rouge, vert, et bleu intégré au substrat.

**[0025]** Selon une caractéristique de l'invention, le réflecteur est réalisé dans un matériau sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W.

**[0026]** Ainsi, de tels matériaux métalliques possèdent à la fois un coefficient de réflexion en intensité élevée dans le domaine visible, et une conductivité électrique élevée.

**[0027]** Selon une caractéristique de l'invention, le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux des première, deuxième et troisième portions de la couche d'espacement est sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W.

**[0028]** Ainsi, de tels matériaux métalliques possèdent à la fois un coefficient de réflexion en intensité élevée dans le domaine visible, et une conductivité électrique élevée.

**[0029]** Selon une caractéristique de l'invention, la couche d'espacement est réalisée dans un matériau électriquement conducteur et transparent dans le domaine visible, de préférence un oxyde, plus préférentiellement sélectionné parmi l'oxyde d'indium-étain, l'oxyde d'étain SnO<sub>2</sub>, l'oxyde de zinc ZnO.

**[0030]** Selon une caractéristique de l'invention, les première, deuxième et troisième portions de la couche d'espacement comportent des bords latéraux électriquement isolés entre eux.

**[0031]** Selon une caractéristique de l'invention, la première électrode est réalisée en oxyde d'indium-étain.

**[0032]** Selon une caractéristique de l'invention, la deuxième électrode est réalisée dans un matériau sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W.

**[0033]** Selon une caractéristique de l'invention, le substrat est réalisé dans un matériau semi-conducteur, de préférence le silicium.

**[0034]** L'invention a également pour objet un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant une matrice de pixels conformes à l'invention.

**[0035]** L'invention a également pour objet un procédé de fabrication d'un pixel d'un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant les étapes :

- a) prévoir un substrat ;
- b) former un réflecteur, réfléchissant dans le domaine visible, sur le substrat ;
- c) former une couche d'espacement sur le

réflecteur ;

d) former une première électrode, transparente dans le domaine visible, sur la couche d'espacement ;

e) former un empilement de couches électroluminescentes organiques sur la première électrode, l'empilement étant configuré pour émettre une lumière blanche ;

f) former une seconde électrode, semi-transparente dans le domaine visible, sur l'empilement ; la seconde électrode et le réflecteur formant un résonateur optique ;

l'étape c) étant exécutée de sorte que la couche d'espacement possède des première, deuxième, et troisième portions présentant des épaisseurs adaptées de sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue issues de la lumière blanche émise par l'empilement, de manière à définir respectivement des sous-pixels rouge, vert et bleu ; les première et deuxième portions de la couche d'espacement présentant des bords latéraux ; remarquable en ce que l'étape c) comporte une étape consistant à recouvrir, d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible, les bords latéraux des première et deuxième portions de la couche d'espacement.

#### Brève description des dessins

**[0036]** D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront dans l'exposé détaillé de différents modes de réalisation de l'invention, l'exposé étant assorti d'exemples et de références aux dessins joints.

Figure 1 est une vue schématique en coupe d'un pixel selon l'invention, illustrant un premier mode de réalisation de la couche d'espacement, la coupe étant effectuée suivant la normale à la surface du pixel.

Figure 2 est une vue schématique en coupe d'un pixel selon l'invention, illustrant un deuxième mode de réalisation de la couche d'espacement, la coupe étant effectuée suivant la normale à la surface du pixel.

Figures 3a à 3k sont des vues schématiques en coupe selon la normale au substrat, illustrant des étapes d'un premier procédé de fabrication selon l'invention.

Figures 4a à 4k sont des vues schématiques en coupe selon la normale au substrat, illustrant des étapes d'un deuxième procédé de fabrication selon l'invention.

Figures 5a à 5k sont des vues schématiques en coupe selon la normale au substrat, illustrant des étapes d'un troisième procédé de fabrication selon l'invention.

Figures 6a à 6h sont des vues schématiques en coupe selon la normale au substrat, illustrant des étapes d'un quatrième procédé de fabrication selon l'inven-

tion.

**[0037]** Il est à noter que les dessins décrits ci-avant sont schématiques et ne sont pas à l'échelle par souci de lisibilité et pour simplifier leur compréhension.

### Exposé détaillé des modes de réalisation

**[0038]** Les éléments identiques ou assurant la même fonction porteront les mêmes références pour les différents modes de réalisation, par souci de simplification.

**[0039]** Un objet de l'invention est un pixel d'un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant successivement :

- un substrat 1 ;
- un réflecteur 2, réfléchissant dans le domaine visible, et formé sur le substrat 1 ;
- une couche d'espacement 3, formée sur le réflecteur 2 ;
- une première électrode  $E_1$ , transparente dans le domaine visible, et formée sur la couche d'espacement 3 ;
- un empilement 4 de couches électroluminescentes organiques, configuré pour émettre une lumière blanche, et formé sur la première électrode  $E_1$ ,
- une seconde électrode  $E_2$ , semi-transparente dans le domaine visible, et formée sur l'empilement 4 ; la seconde électrode  $E_2$  et le réflecteur 2 formant un résonateur optique ;

la couche d'espacement 3 possédant des première, deuxième, et troisième portions 30, 31, 32 présentant des épaisseurs adaptées de sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue issues de la lumière blanche émise par l'empilement 4, de manière à définir respectivement des sous-pixels rouge, vert et bleu PR, PV, PB.

**[0040]** Les première et deuxième portions 30, 31 de la couche d'espacement 3 comportent chacune des bords latéraux 300 recouverts d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible.

### Couche d'espacement

**[0041]** Comme illustré à la figure 1, la troisième portion 32 de la couche d'espacement 3 peut comporter des bords latéraux 300 recouverts d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible. Le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux 300 des première, deuxième et troisième portions 30, 31, 32 de la couche d'espacement 3 est avantageusement électriquement conducteur. Le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux 300 des première, deuxième et troisième portions 30, 31, 32 de la couche d'espacement 3 est avantageusement sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W. Le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux 300 des première, deuxième et troisième portions 30, 31, 32 de

la couche d'espacement 3 possède un coefficient de réflexion en intensité supérieur ou égal à 70%, de préférence supérieur ou égal à 80%, plus préférentiellement supérieur ou égal à 85%, encore plus préférentiellement supérieur ou égal à 90%, moyenné sur le domaine visible.

**[0042]** Selon une alternative illustrée à la figure 2, l'épaisseur de la troisième portion 32 de la couche d'espacement 3 est nulle, et le résonateur optique présente une épaisseur adaptée pour autoriser la transmission d'une lumière bleue issue de la lumière blanche émise par l'empilement 4.

**[0043]** La couche d'espacement 3 est avantageusement réalisée dans un matériau électriquement conducteur et transparent dans le domaine visible, de préférence un oxyde, plus préférentiellement sélectionné parmi l'oxyde d'indium-étain, l'oxyde d'étain  $\text{SnO}_2$ , l'oxyde de zinc  $\text{ZnO}$ .

### Substrat

**[0044]** Le substrat 1 est avantageusement réalisé dans un matériau semi-conducteur, de préférence le silicium.

**[0045]** Le substrat 1 comporte avantageusement une couche diélectrique 5 structurée, de préférence réalisée en  $\text{SiO}_2$  ou en  $\text{SiN}$ , sur laquelle est formé le réflecteur 2. La couche diélectrique 5 structurée comprend des premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 associés respectivement aux sous-pixels rouge, vert et bleu PR, PV, PB. Les premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 sont séparés entre eux d'une distance correspondant à la distance souhaitée entre les sous-pixels, par exemple de l'ordre de 600 nm. Les premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 de la couche diélectrique 5 structurée présentent avantageusement des épaisseurs adaptées aux épaisseurs des première, deuxième et troisième portions 30, 31, 32 de la couche d'espacement 3 de manière à obtenir une première électrode  $E_1$  plane.

**[0046]** Les premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 comportent avantageusement chacun des bords latéraux 500 recouverts d'un matériau électriquement conducteur, de préférence sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W. Le cas échéant, les bords latéraux 500 des premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 sont électriquement isolés entre eux, de préférence par l'intermédiaire d'une couche diélectrique intercalaire 6, par exemple réalisée en  $\text{SiO}_2$  ou en  $\text{SiN}$ . La couche diélectrique intercalaire 6 s'étend avantageusement jusqu'à affleurer la surface de la première électrode  $E_1$ . Ainsi, les bords latéraux 300 des première, deuxième et troisième portions 30, 31, 32 de la couche d'espacement 3 sont électriquement isolés entre eux par la couche diélectrique intercalaire 6.

**[0047]** Les bords latéraux 500 des premier et deuxième motifs 50, 51 de la couche diélectrique 5 structurée s'étendent avantageusement respectivement dans le prolongement des bords latéraux 300 des première et

deuxième portions 30, 31 de la couche d'espacement 3. Lorsque la troisième portion 32 de la couche d'espacement 3 comporte des bords latéraux 300 recouverts d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible, les bords latéraux 500 du troisième motif 52 de la couche diélectrique 5 structurée s'étendent avantageusement dans le prolongement des bords latéraux 300 de la troisième portion 32 de la couche d'espacement 3.

**[0048]** Le substrat 1 peut comporter un circuit CMOS formant un circuit de commande des sous-pixels rouge, vert et bleu PR, PV, PB. Les bords latéraux 500 des premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 de la couche diélectrique 5 structurée sont avantageusement reliés électriquement au circuit CMOS.

### Réflecteur

**[0049]** Le réflecteur 2 est réalisé dans un matériau, de préférence métallique, plus préférentiellement sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W. Le matériau dans lequel est réalisé le réflecteur 2 est avantageusement identique au matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux 300 des première, deuxième et troisième portions 30, 31, 32 de la couche d'espacement 3 afin de simplifier le procédé de fabrication. De la même façon, le matériau dans lequel est réalisé le réflecteur 2 est avantageusement identique au matériau électriquement conducteur recouvrant les bords latéraux 500 des premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 de la couche diélectrique 5 structurée afin de simplifier le procédé de fabrication.

**[0050]** Le réflecteur 2 présente préférentiellement une épaisseur comprise entre 0,1  $\mu\text{m}$  et 2  $\mu\text{m}$ .

**[0051]** Le réflecteur 2 possède un coefficient de réflexion en intensité supérieur ou égal à 70%, de préférence supérieur ou égal à 80%, plus préférentiellement supérieur ou égal à 85%, encore plus préférentiellement supérieur ou égal à 90%, moyenné sur le domaine visible.

### Première et seconde électrodes

**[0052]** Les première et seconde électrodes  $E_1$ ,  $E_2$  de chaque sous-pixel rouge, vert, bleu PR, PV, PB présentent une épaisseur constante.

**[0053]** La première électrode  $E_1$  de chaque sous-pixel rouge, vert, bleu PR, PV, PB est avantageusement réalisée en oxyde d'indium-étain. La première électrode  $E_1$  de chaque sous-pixel rouge, vert, bleu PR, PV, PB possède un coefficient de transmission en intensité supérieur ou égal à 70%, de préférence supérieur ou égal à 80%, plus préférentiellement supérieur ou égal à 85%, encore plus préférentiellement supérieur ou égal à 90%, moyenné sur le domaine visible.

**[0054]** La seconde électrode  $E_2$  de chaque sous-pixel rouge, vert, bleu PR, PV, PB est avantageusement réalisée dans un matériau métallique, de préférence sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W. La seconde électrode  $E_2$  de chaque sous-pixel rouge, vert, bleu PR, PV, PB possède un coefficient de transmission en intensité stric-

tement inférieur à 80%, de préférence strictement inférieur à 70%, plus préférentiellement strictement inférieur à 60%, moyenné sur le domaine visible. A titre d'exemple non limitatif, la seconde électrode  $E_2$  de chaque sous-pixel rouge, vert, bleu PR, PV, PB peut être réalisée en Al avec une épaisseur comprise entre 10 nm et 20 nm.

**[0055]** La première électrode  $E_1$  est préférentiellement une anode et la seconde électrode  $E_2$  est préférentiellement une cathode.

**[0056]** La seconde électrode  $E_2$  est avantageusement revêtue d'une couche d'encapsulation 7 adaptée pour protéger de l'air et de l'humidité la seconde électrode  $E_2$  et l'empilement 4 de chaque sous-pixel rouge, vert et bleu PR, PV, PB.

15

### Empilement de couches électroluminescente organiques

**[0057]** L'empilement 4 de couches électroluminescentes organiques présente une épaisseur constante pour chaque sous-pixel rouge, vert et bleu PR, PV, PB.

**[0058]** A titre d'exemple non limitatif, l'empilement 4 peut comporter trois couches émissives en tandem. Plus précisément, lorsque la première électrode  $E_1$  est une anode et la seconde électrode  $E_2$  est une cathode, l'empilement 4 peut comporter :

- une première couche de transport de trous formée sur la première électrode  $E_1$  ;
- une première couche émissive émettant une lumière bleue, formée sur la première couche de transport de trous ;
- une première couche de transport d'électrons, formée sur la première couche émissive ;
- une couche de génération de charges (appelée également couche d'interconnexion), formée sur la première couche de transport d'électrons ;
- une seconde couche de transport de trous, formée sur la couche de génération de charges ;
- une deuxième couche émissive émettant une lumière verte, formée sur la seconde couche de transport de trous ;
- une troisième couche émissive émettant une lumière rouge, formée sur la deuxième couche émissive ;
- une seconde couche de transport d'électrons, formée sur la troisième couche émissive, et destinée à être revêtue de la seconde électrode  $E_2$ .

**[0059]** A titre de variantes, l'empilement 4 peut comporter :

- trois couches émissives émettant respectivement des lumières bleue, verte et rouge sans être agencées en tandem (structure conventionnelle) ;
- deux couches émissives émettant respectivement des lumières jaune et bleue agencées en structure conventionnelle ;
- deux couches émissives émettant respectivement

des lumières jaune et bleue agencées en structure tandem.

### Micro-écran

**[0060]** Un objet de l'invention est un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant une matrice de pixels conformes à l'invention. Les pixels de la matrice présentent préférentiellement un pas compris entre 4  $\mu\text{m}$  et 5  $\mu\text{m}$ .

### Procédé de fabrication du pixel

**[0061]** Un objet de l'invention est un procédé de fabrication d'un pixel d'un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant les étapes :

- a) prévoir un substrat 1 ;
- b) former un réflecteur 2, réfléchissant dans le domaine visible, sur le substrat 1 ;
- c) former une couche d'espacement 3 sur le réflecteur 2 ;
- d) former une première électrode  $E_1$ , transparente dans le domaine visible, sur la couche d'espacement 3 ;
- e) former un empilement 4 de couches électroluminescentes organiques sur la première électrode  $E_1$ , l'empilement 4 étant configuré pour émettre une lumière blanche ;
- f) former une seconde électrode  $E_2$ , semi-transparente dans le domaine visible, sur l'empilement 4 ; la seconde électrode  $E_2$  et le réflecteur 2 formant un résonateur optique.

**[0062]** L'étape c) est exécutée de sorte que la couche d'espacement 3 possède des première, deuxième, et troisième portions 30, 31, 32 présentant des épaisseurs adaptées de sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue issues de la lumière blanche émise par l'empilement 4, de manière à définir respectivement des sous-pixels rouge, vert et bleu PR, PV, PB ; les première et deuxième portions 30, 31 de la couche d'espacement 3 présentant des bords latéraux 300.

**[0063]** L'étape c) comporte une étape consistant à recouvrir, d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible, les bords latéraux 300 des première et deuxième portions 30, 31 de la couche d'espacement 3.

### Premier mode de mise en oeuvre (figures 3a à 3k)

**[0064]** Comme illustré à la figure 3a, l'étape a) peut être exécutée par trois dépôts successifs de  $\text{SiO}_2$  sur le substrat 1, formant les premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 de la couche diélectrique 5 structurée.

**[0065]** Comme illustré à la figure 3b, l'étape b) comporte un dépôt du matériau du réflecteur 2, par exemple Al avec une épaisseur de 100 nm. Le dépôt peut être

exécuté par un dépôt physique en phase vapeur.

**[0066]** Comme illustré à la figure 3c, l'étape c) comporte un dépôt pleine plaque du matériau de la couche d'espacement 3 et une étape d'aplanissement, de préférence exécutée par polissage mécano-chimique.

**[0067]** Comme illustré à la figure 3d, les étapes b) et c) sont finalisées par lithogravure de manière à graver les matériaux du réflecteur 2 et de la couche d'espacement 3 et délimiter les sous-pixels rouge, vert et bleu PR, PV, PB.

**[0068]** Comme illustré à la figure 3e, l'étape c) comporte une étape  $c_1$ ) consistant à recouvrir, d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible, les bords latéraux 300 des première, deuxième et troisième portions 30, 31, 32 de la couche d'espacement 3. L'étape  $c_1$ ) peut être exécutée par un dépôt du matériau réfléchissant, par exemple Al avec une épaisseur de 100 nm. L'étape  $c_1$ ) conduit également à recouvrir du matériau réfléchissant les bords latéraux 500 des premier, deuxième et troisième motifs 50, 51, 52 de la couche diélectrique 5 structurée, le matériau réfléchissant étant choisi pour être également électriquement conducteur.

**[0069]** Comme illustrée aux figures 3f et 3g, l'étape  $c_1$ ) est suivie d'une gravure du fond des tranchées puis d'un remplissage des tranchées d'une couche diélectrique intercalaire 6, par exemple réalisée en  $\text{SiO}_2$  ou en SiN.

**[0070]** Comme illustrée à la figure 3h, le procédé comporte une étape d'aplanissement, de préférence exécutée par polissage mécano-chimique, de manière à rendre libre la surface de la couche d'espacement 3.

**[0071]** Comme illustré aux figures 3i et 3j, l'étape d) comporte un dépôt pleine plaque de la première électrode  $E_1$ , suivi d'une lithogravure adaptée pour délimiter les sous-pixels rouge, vert et bleu PR, PV, PB.

**[0072]** Comme illustré à la figure 3k, les étapes e) et f) sont exécutées par des techniques de dépôt connues de l'homme du métier. Le procédé peut comporter également une étape consistant à former une couche d'encapsulation 7 sur la seconde électrode  $E_2$ . Le procédé peut comporter également une étape consistant à étendre la couche diélectrique intercalaire 6 jusqu'à affleurer la surface de la première électrode  $E_1$ .

### Deuxième mode de mise en oeuvre (figures 4a à 4k)

**[0073]** Comme illustré à la figure 4c, le deuxième mode de mise en oeuvre diffère du premier mode de mise en oeuvre en ce que l'étape d'aplanissement, de préférence un polissage mécano-chimique, de l'étape c) s'arrête sur le matériau du réflecteur 2 s'étendant sur le troisième motif 52 de la couche diélectrique 5 structurée. Ainsi, l'épaisseur de la troisième portion 32 de la couche d'espacement 3 est nulle, et les épaisseurs des première et deuxième portions 30, 31 de la couche d'espacement 3 sont parfaitement contrôlées.

### Troisième mode de mise en oeuvre (figures 5a à 5k)

**[0074]** Comme illustré à la figure 5a, le troisième mode de mise en oeuvre diffère du deuxième mode de mise en oeuvre en ce que la couche diélectrique structurée 5 est déposée en formant des marches continues.

### Quatrième mode de mise en oeuvre (figures 6a à 6h)

**[0075]** Comme illustré aux figures 6a et 6b, l'étape a) peut être exécutée par un dépôt pleine plaque d'une couche diélectrique 5' (par exemple en  $\text{SiO}_2$  et d'une épaisseur de 150 nm) sur le substrat 1, suivi d'une structuration de la couche diélectrique 5' (par lithogravure) de manière à obtenir une couche diélectrique 5 structurée et délimiter les sous-pixel rouge, vert et bleu PR, PV, PB.

**[0076]** Comme illustré à la figure 6c, l'étape b) comporte un dépôt du matériau du réflecteur 2, par exemple Al avec une épaisseur de 100 nm, sur la couche diélectrique 5 structurée. Le dépôt peut être exécuté par un dépôt physique en phase vapeur.

**[0077]** Comme illustré à la figure 6d, le matériau du réflecteur 2 superficiel est ôté par exemple par polissage mécano-chimique.

**[0078]** Comme illustré à la figure 6e, l'étape c) comporte :

- un dépôt du matériau de la couche d'espacement 3 sur le matériau du réflecteur 2 de sorte que les bords latéraux 300 des première, deuxième et troisième portions 30, 31, 32 de la couche d'espacement 3 sont recouverts du matériau du réflecteur 2,
- un aplanissement de la couche d'espacement 3, de préférence par polissage mécano-chimique.

**[0079]** Comme illustré aux figures 6f et 6g, l'étape d) comporte un dépôt pleine plaque de la première électrode  $E_1$ , suivi d'une lithogravure adaptée pour délimiter les sous-pixels rouge, vert et bleu PR, PV, PB.

**[0080]** Comme illustré à la figure 6h, les étapes e) et f) sont exécutées par des techniques de dépôt connues de l'homme du métier. Le procédé peut comporter également une étape consistant à former une couche d'encapsulation 7 sur la seconde électrode  $E_2$ . Le procédé peut comporter également une étape consistant à former une couche diélectrique intercalaire 6 sur la couche diélectrique 5 structurée jusqu'à affleurer la surface de la première électrode  $E_1$ .

**[0081]** L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation exposés. L'homme du métier est mis à même de considérer leurs combinaisons techniquement opérantes, et de leur substituer des équivalents.

### Revendications

1. Pixel d'un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant successivement :

- un substrat (1) ;
- un réflecteur (2), réfléchissant dans le domaine visible, et formé sur le substrat (1) ;
- une couche d'espacement (3), formée sur le réflecteur (2) ;
- une première électrode ( $E_1$ ), transparente dans le domaine visible, et formée sur la couche d'espacement (3) ;
- un empilement (4) de couches électroluminescentes organiques, configuré pour émettre une lumière blanche, et formé sur la première électrode ( $E_1$ ),
- une seconde électrode ( $E_2$ ), semi-transparente dans le domaine visible, et formée sur l'empilement (4) ; la seconde électrode ( $E_2$ ) et le réflecteur (2) formant un résonateur optique ;

la couche d'espacement (3) possédant des première, deuxième, et troisième portions (30, 31, 32) présentant des épaisseurs adaptées de sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue issues de la lumière blanche émise par l'empilement (4), de manière à définir respectivement des sous-pixels rouge, vert et bleu (PR, PV, PB) ;

**caractérisé en ce que** les première et deuxième portions (30, 31) de la couche d'espacement (3) comportent chacune des bords latéraux (300) recouverts d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible.

2. Pixel selon la revendication 1, dans lequel la troisième portion (32) de la couche d'espacement (3) comporte des bords latéraux (300) recouverts d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible.
3. Pixel selon la revendication 1, dans lequel l'épaisseur de la troisième portion (32) de la couche d'espacement (3) est nulle, et dans lequel le résonateur optique présente une épaisseur adaptée pour autoriser la transmission d'une lumière bleue issue de la lumière blanche émise par l'empilement (4).
4. Pixel selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le substrat (1) comporte une couche diélectrique (5) structurée, de préférence réalisée en  $\text{SiO}_2$  ou en  $\text{SiN}$ , sur laquelle est formé le réflecteur (2); la couche diélectrique (5) structurée comprenant des premier, deuxième et troisième motifs (50, 51, 52) associés respectivement aux sous-pixels rouge, vert et bleu (PR, PV, PB) ; et dans lequel les premier, deuxième et troisième motifs (50, 51, 52) comportent chacun des bords latéraux (500) recouverts d'un matériau électriquement conducteur, de préférence sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W ; les bords latéraux (500) des premier, deuxième et troisième motifs (50, 51, 52) étant électriquement isolés entre eux.

5. Pixel selon la revendication 4 en combinaison avec la revendication 1 ou 3, dans lequel le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux (300) des première et deuxième portions (30, 31) de la couche d'espacement (3) est électriquement conducteur ; et dans lequel les bords latéraux (500) des premier et deuxième motifs (50, 51) de la couche diélectrique (5) structurée s'étendent respectivement dans le prolongement des bords latéraux (300) des première et deuxième portions (30, 31) de la couche d'espacement (3).
6. Pixel selon la revendication 4 en combinaison avec la revendication 2, dans lequel le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux (300) des première, deuxième et troisième portions (30, 31, 32) de la couche d'espacement (3) est électriquement conducteur ; et dans lequel les bords latéraux (500) des premier, deuxième et troisième motifs (50, 51, 52) de la couche diélectrique (5) structurée s'étendent respectivement dans le prolongement des bords latéraux (300) des première, deuxième et troisième portions (30, 31, 32) de la couche d'espacement (3).
7. Pixel selon la revendication 5 ou 6, dans lequel le substrat (1) comporte un circuit CMOS ; et dans lequel les bords latéraux (500) des premier, deuxième et troisième motifs (50, 51, 52) de la couche diélectrique (5) structurée sont reliés électriquement au circuit CMOS.
8. Pixel selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel le réflecteur (2) est réalisé dans un matériau sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W.
9. Pixel selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel le matériau réfléchissant recouvrant les bords latéraux (300) des première, deuxième et troisième portions (30, 31, 32) de la couche d'espacement (3) est sélectionné parmi Al, Ag, Pt, Cr, Ni, W.
10. Pixel selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel la couche d'espacement (3) est réalisée dans un matériau électriquement conducteur et transparent dans le domaine visible, de préférence un oxyde, plus préférentiellement sélectionné parmi l'oxyde d'indium-étain, l'oxyde d'étain SnO<sub>2</sub>, l'oxyde de zinc ZnO.
11. Pixel selon l'une des revendications 1 à 10, dans lequel les première, deuxième et troisième portions (30, 31, 32) de la couche d'espacement (3) comportent des bords latéraux (300) électriquement isolés entre eux.
12. Micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant une matrice de pixels selon l'une

des revendications 1 à 11.

13. Procédé de fabrication d'un pixel d'un micro-écran à diodes électroluminescentes organiques, comportant les étapes :

- a) prévoir un substrat (1) ;  
 b) former un réflecteur (2), réfléchissant dans le domaine visible, sur le substrat (1) ;  
 c) former une couche d'espacement (3) sur le réflecteur (2) ;  
 d) former une première électrode (E<sub>1</sub>), transparente dans le domaine visible, sur la couche d'espacement (3) ;  
 e) former un empilement (4) de couches électroluminescentes organiques sur la première électrode (E<sub>1</sub>), l'empilement (4) étant configuré pour émettre une lumière blanche ;  
 f) former une seconde électrode (E<sub>2</sub>), semi-transparente dans le domaine visible, sur l'empilement (4) ; la seconde électrode (E<sub>2</sub>) et le réflecteur (2) formant un résonateur optique ;

l'étape c) étant exécutée de sorte que la couche d'espacement (3) possède des première, deuxième, et troisième portions (30, 31, 32) présentant des épaisseurs adaptées de sorte que le résonateur optique autorise respectivement la transmission de lumières rouge, verte et bleue issues de la lumière blanche émise par l'empilement (4), de manière à définir respectivement des sous-pixels rouge, vert et bleu (PR, PV, PB) ; les première et deuxième portions (30, 31) de la couche d'espacement (3) présentant des bords latéraux (300) ;

**caractérisé en ce que** l'étape c) comporte une étape consistant à recouvrir, d'un matériau réfléchissant dans le domaine visible, les bords latéraux (300) des première et deuxième portions (30, 31) de la couche d'espacement (3).

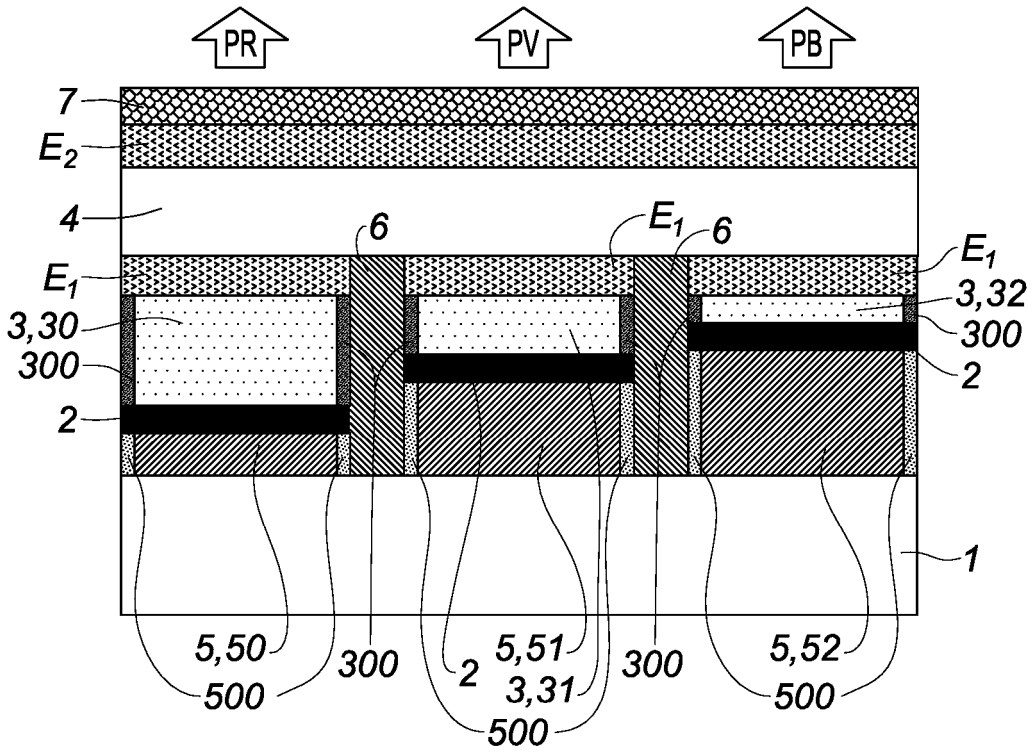


Fig. 1

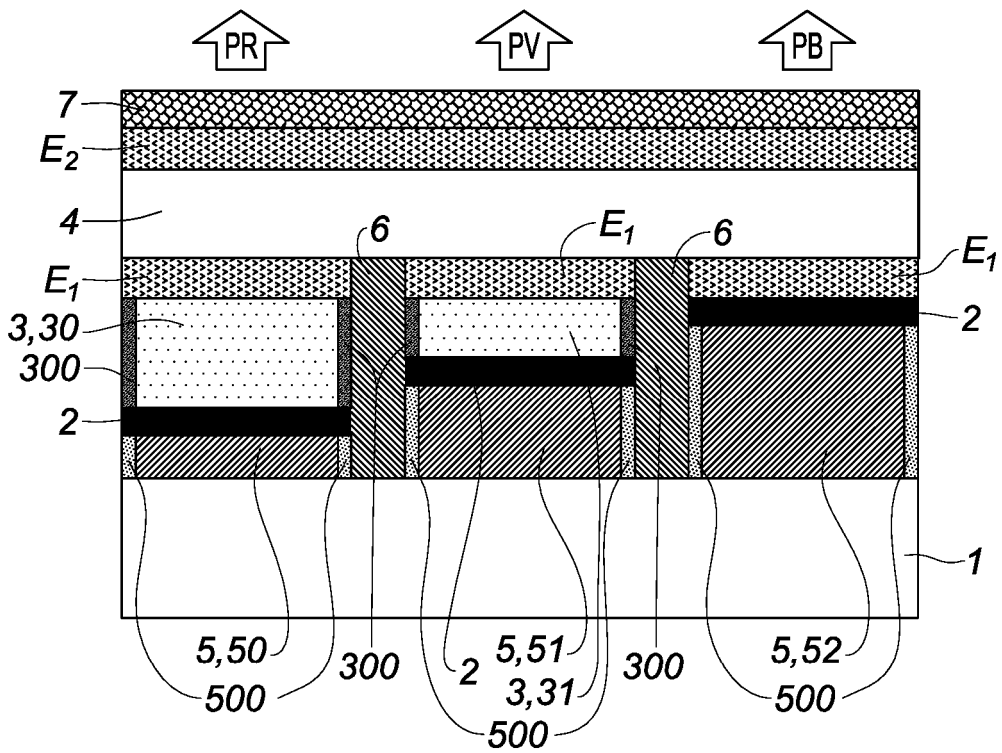


Fig. 2

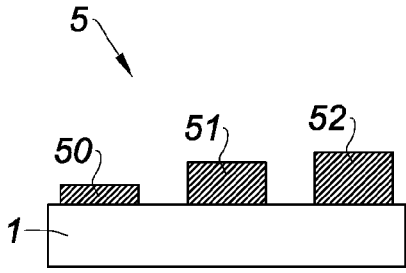


Fig. 3a

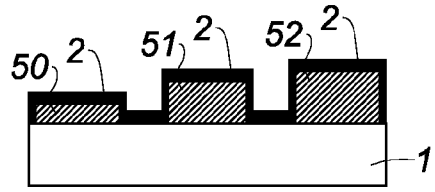


Fig. 3b

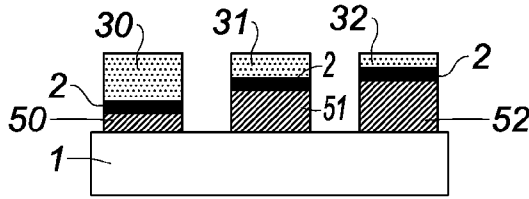


Fig. 3d

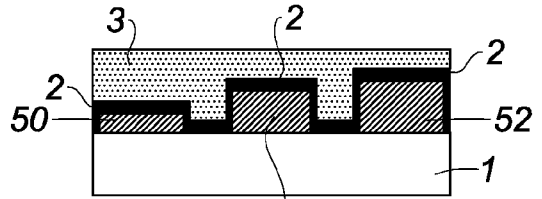


Fig. 3c

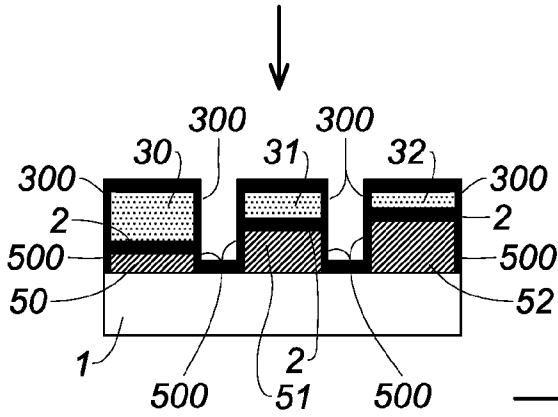


Fig. 3e

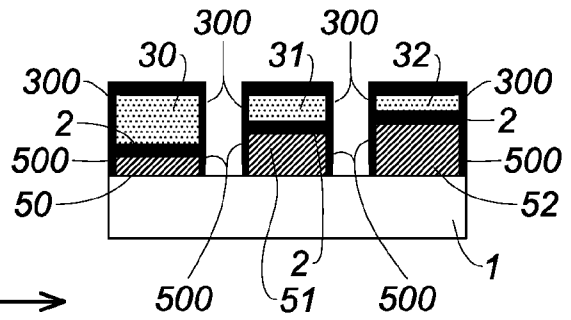


Fig. 3f

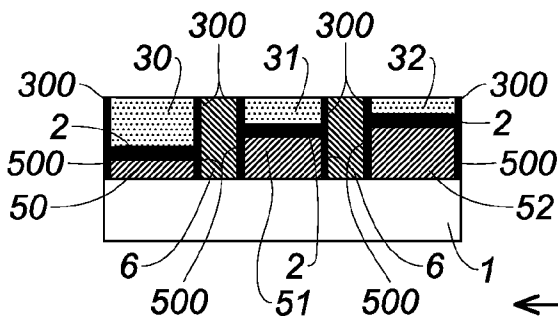


Fig. 3h

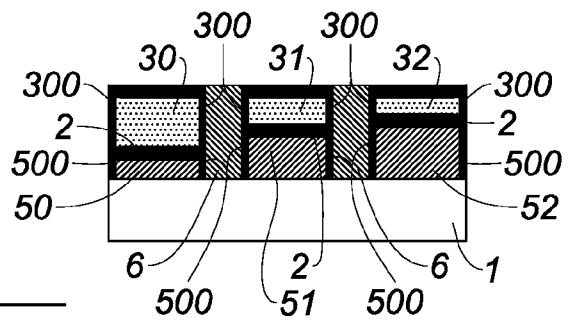
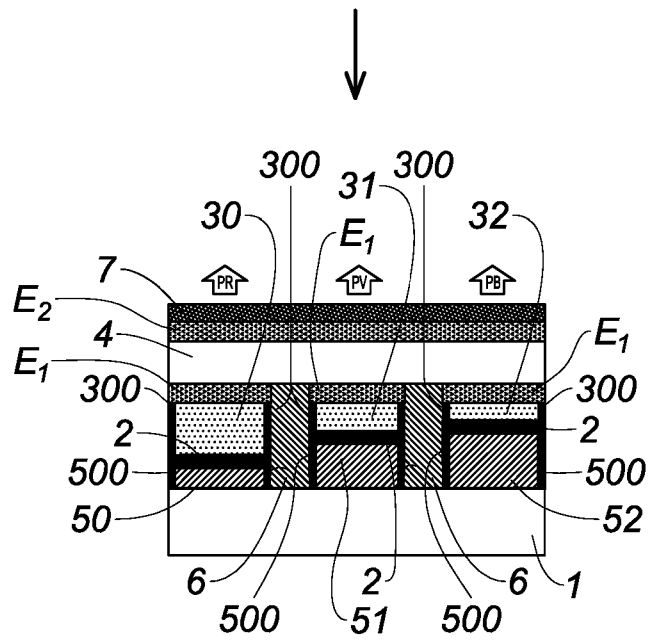
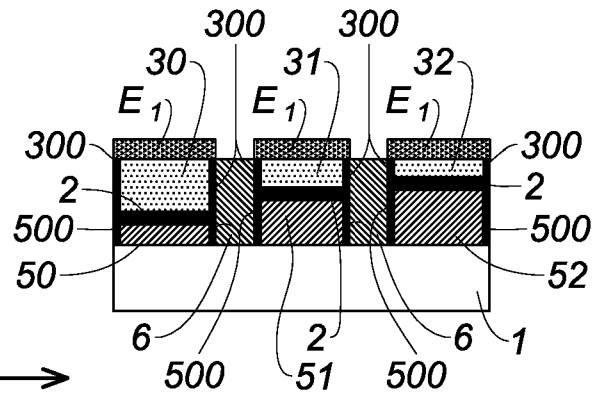
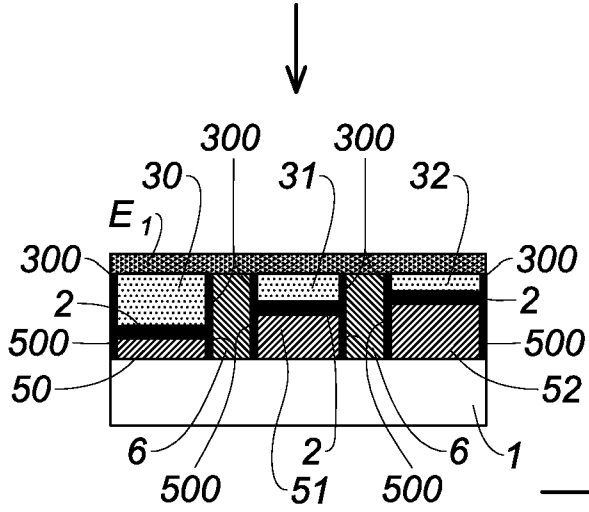


Fig. 3g



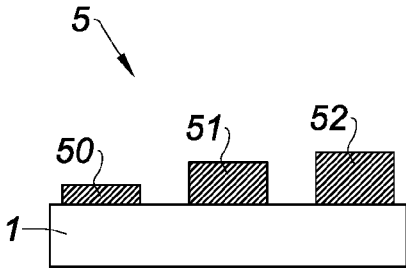


Fig. 4a

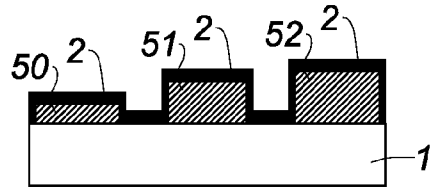


Fig. 4b

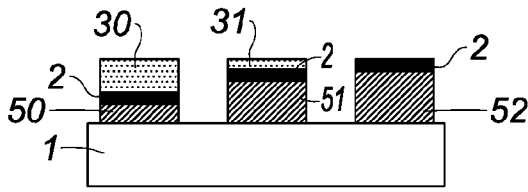


Fig. 4d

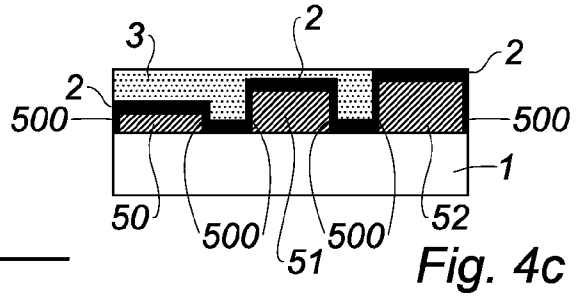


Fig. 4c

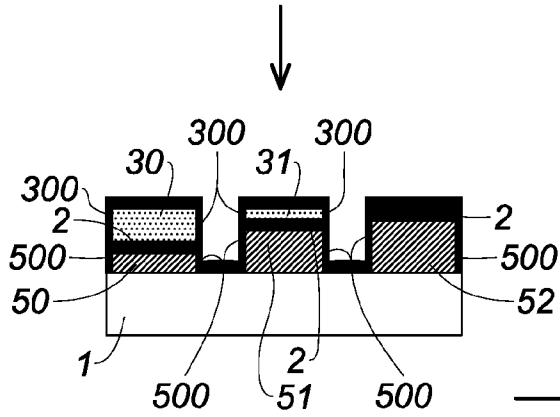


Fig. 4e

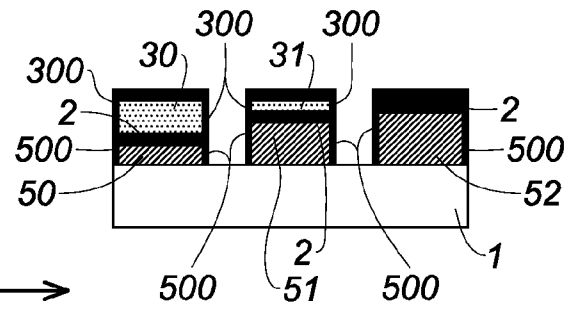


Fig. 4f

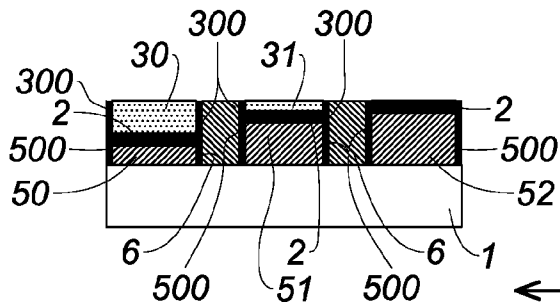


Fig. 4h

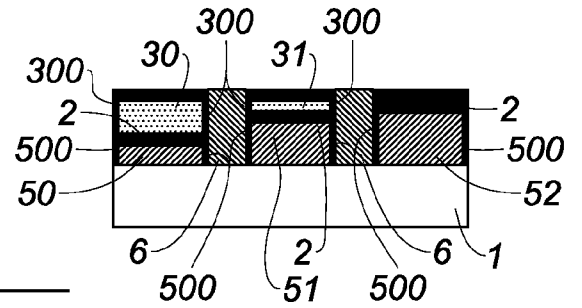


Fig. 4g

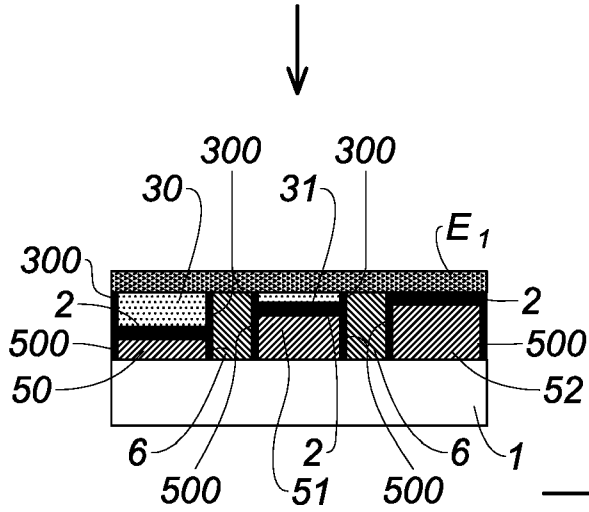


Fig. 4i

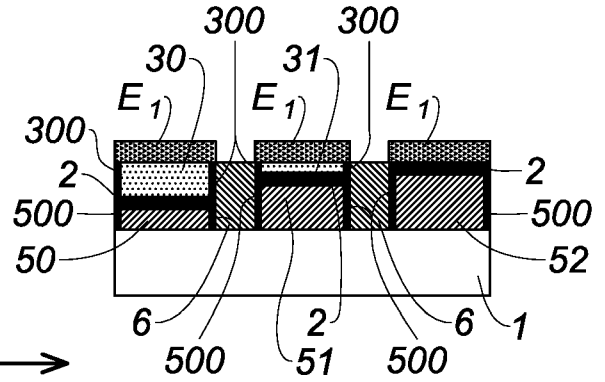


Fig. 4j

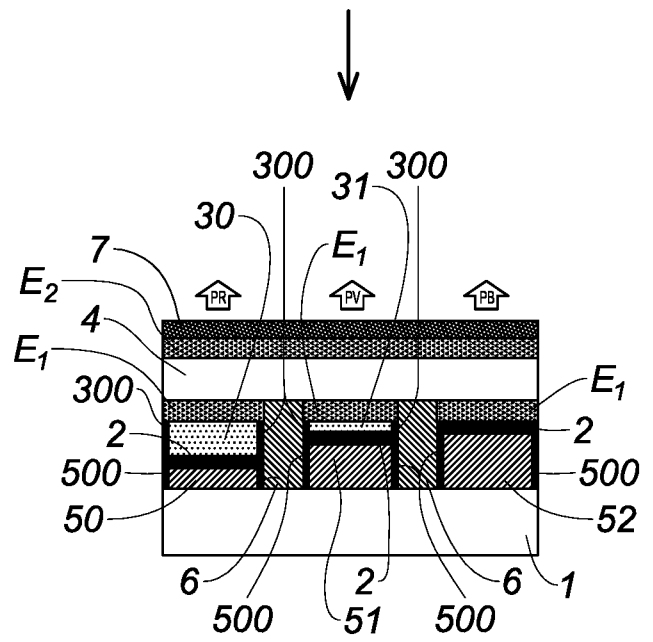


Fig. 4k

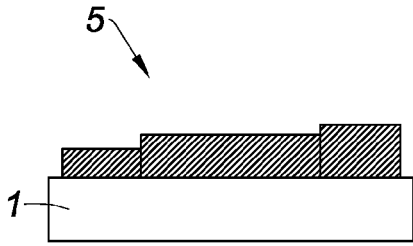


Fig. 5a

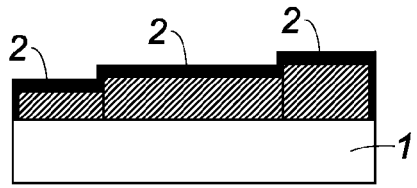


Fig. 5b

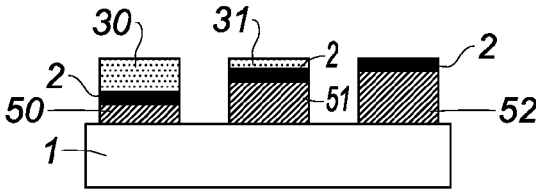


Fig. 5d

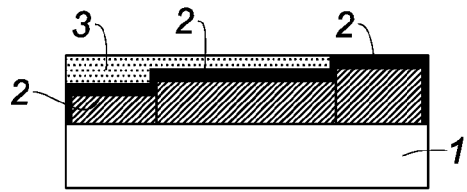


Fig. 5c

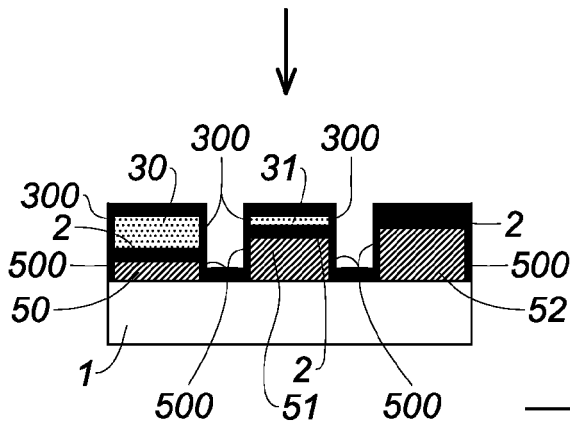


Fig. 5e

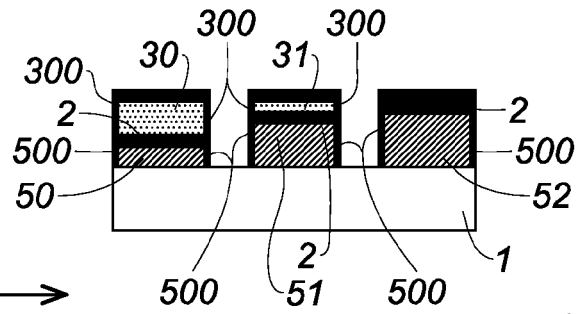


Fig. 5f

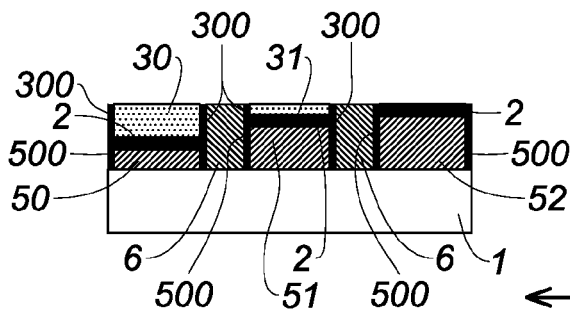


Fig. 5h

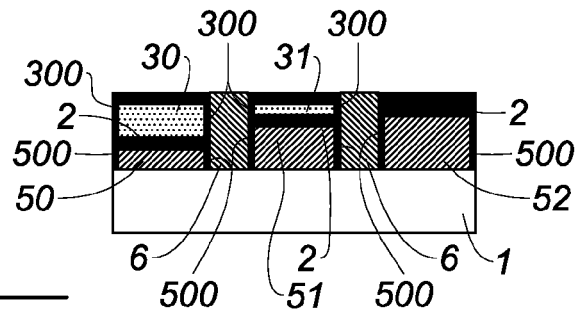


Fig. 5g



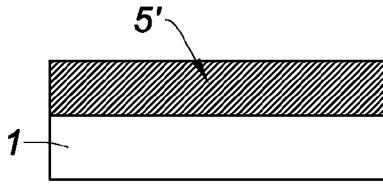


Fig. 6a

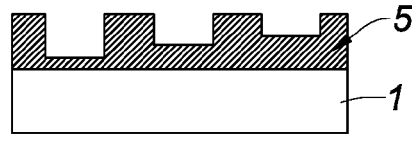


Fig. 6b

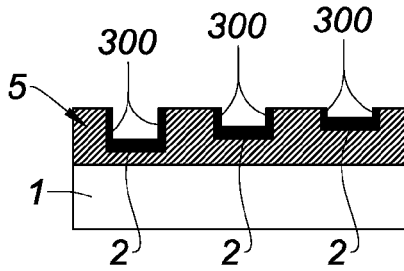


Fig. 6d

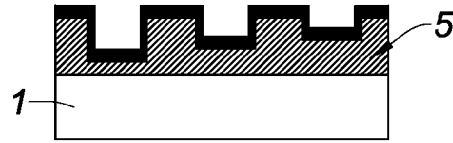


Fig. 6c

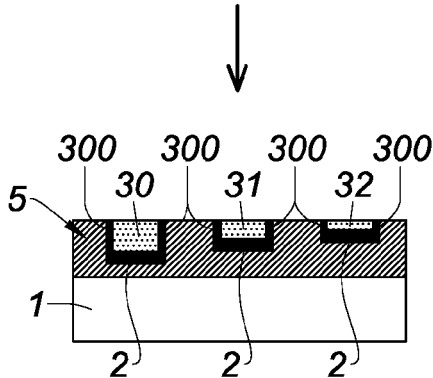


Fig. 6e

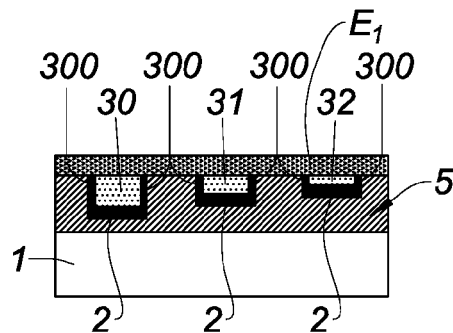


Fig. 6f

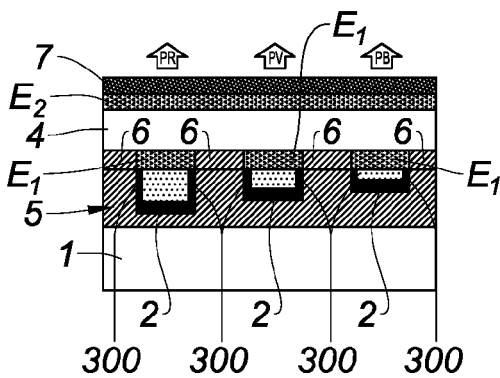


Fig. 6h

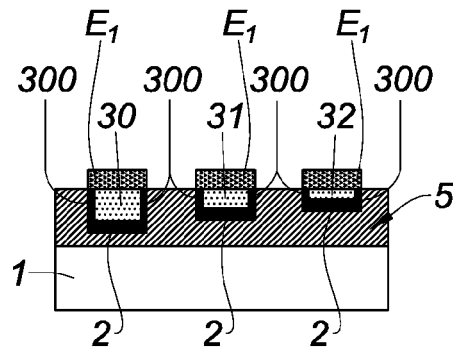


Fig. 6g



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 19 19 2318

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IPC)
A,D	US 2014/295597 A1 (SATO HISAKATSU [JP] ET AL) 2 octobre 2014 (2014-10-02) * le document en entier * -----	1-13	INV. H01L27/32 H01L51/52
A,D	US 2017/154932 A1 (KASHIWABARA MITSUHIRO [JP] ET AL) 1 juin 2017 (2017-06-01) * le document en entier * -----	1-13	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC)
			H01L
2 Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche <b>Munich</b>		Date d'achèvement de la recherche <b>13 janvier 2020</b>	Examineur <b>Wolfbauer, Georg</b>
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03/82 (P04/C02)

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.

EP 19 19 2318

5 La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

13-01-2020

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2014295597 A1	02-10-2014	CN 104078422 A	01-10-2014
		JP 6164402 B2	19-07-2017
		JP 2014191962 A	06-10-2014
		TW 201438201 A	01-10-2014
		US 2014295597 A1	02-10-2014
		US 2015118774 A1	30-04-2015
US 2017154932 A1	01-06-2017	CN 1868240 A	22-11-2006
		EP 1672962 A1	21-06-2006
		EP 2509397 A1	10-10-2012
		EP 2975665 A1	20-01-2016
		EP 3151302 A1	05-04-2017
		EP 3413369 A1	12-12-2018
		EP 3447816 A1	27-02-2019
		KR 20060079225 A	05-07-2006
		KR 20110067139 A	21-06-2011
		TW 1255669 B	21-05-2006
		US 2007102737 A1	10-05-2007
		US 2011241038 A1	06-10-2011
		US 2013207138 A1	15-08-2013
		US 2014332832 A1	13-11-2014
		US 2015295017 A1	15-10-2015
		US 2016293673 A1	06-10-2016
		US 2017154932 A1	01-06-2017
US 2018197923 A1	12-07-2018		
US 2019326358 A1	24-10-2019		
WO 2005039248 A1	28-04-2005		

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION**

*Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.*

**Documents brevets cités dans la description**

- US 8956898 B2 [0003]
- EP 1672962 A1 [0004]

专利名称(译)	带有有机电致发光二极管的微屏的像素		
公开(公告)号	<a href="#">EP3614439A1</a>	公开(公告)日	2020-02-26
申请号	EP2019192318	申请日	2019-08-19
[标]申请(专利权)人(译)	原子能委员会		
申请(专利权)人(译)	OFFICE原子能和可替代能源		
当前申请(专利权)人(译)	OFFICE原子能和可替代能源		
[标]发明人	MOLLARD LAURENT MAINDRON TONY TOURNAIRE MYRIAM		
发明人	MOLLARD, LAURENT MAINDRON, TONY TOURNAIRE, MYRIAM		
IPC分类号	H01L27/32 H01L51/52		
CPC分类号	H01L27/322 H01L51/504 H01L51/5203 H01L51/5265 H01L51/5271 H01L51/56 H01L27/3211 H01L27/3248 H01L51/5212 H01L27/3293 H01L2251/5315		
优先权	2018057558 2018-08-21 FR		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

像素依次包括基板；在可见光谱中具有反射性的反射器；间隔层；第一透明电极；被配置为发射白光的有机发光层的堆叠；第二半透明电极形成在堆叠上，第二电极和反射器形成光谱谐振器；间隔层具有第一，第二和第三部分，其厚度被调节成使得光学谐振器分别允许透射红色，绿色和蓝色的光；值得注意的是，间隔层的第一和第二部分每个都包括侧向边缘，这些侧向边缘覆盖有在可见光谱中具有反射性的材料。

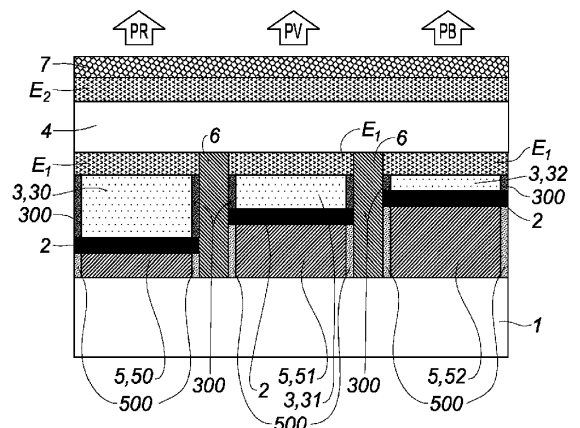


Fig. 1